

2015年3月期(2014年4月～2015年3月)

東京エレクトロン 決算説明会

内容:

➤ 2015年3月期 連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

➤ 事業環境と収益性向上への取り組みについて

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2015年4月27日



TOKYO ELECTRON

Corp IR/April 27, 2015

2015年3月期(2014年4月～2015年3月)

連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

2015年4月27日



TOKYO ELECTRON

損益状況

	2014年3月期	2015年3月期	対前年 増減率	(ご参考) 3/26発表の 2015年3月期予想	(億円)
売上高	6,121	6,131	+0%	6,090	
売上総利益 下段: 売上総利益率	2,018 33.0%	2,427 39.6%	+20%	-	
販管費	1,696	1,546	-9%	-	
営業利益 下段: 営業利益率	322 5.3%	881 14.4%	+174%	870	
税前利益	-117	868	+985億円	-	
当期純利益	-194	718	+912億円	660	
1株当たり当期純利益(円)	-108.31	401.08	---	368.24	
研究開発費	786	713	-9%	-	
設備投資額	127	131	+3%	-	
減価償却実施額	248	208	-16%	-	

売上総利益率が過去最高
東京エレクトロン デバイスが持分法適用関連会社となり
2015年3月期からEC/CN事業が連結対象外へ

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

部門別売上高

(億円)

	2014年3月期		2015年3月期		対前年増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
SPE	4,788	78%	5,762	94%	+20%
FPD	283	5%	327	5%	+16%
PVE	38	1%	36	1%	-
EC/CN	1,007	16%			
その他	4	0%	5	0%	+16%
合計	6,121	100%	6,131	100%	+0%

SPE
(半導体製造装置)

メモリ、ロジック向け投資が活発化し、前年比20%増加。

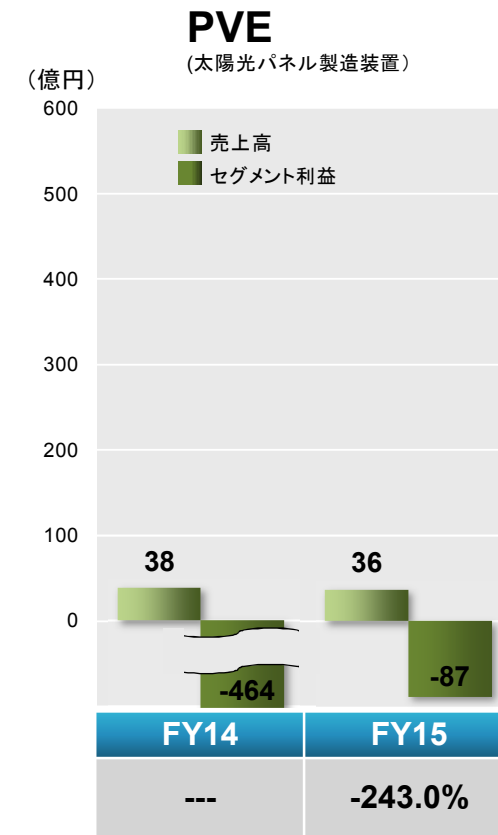
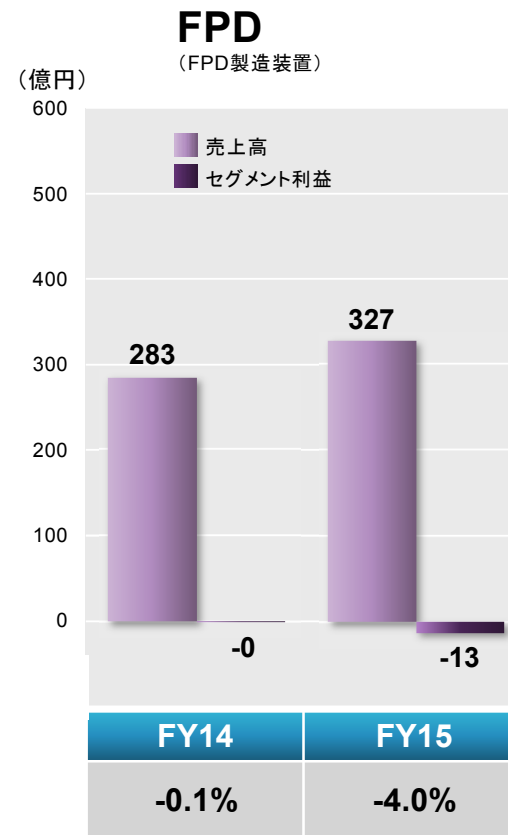
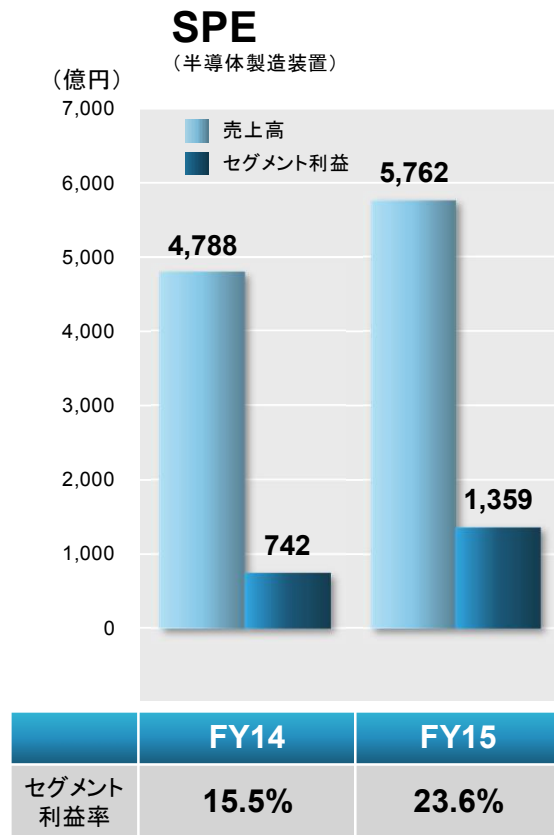
FPD
(FPD製造装置)

中国向けの大型パネル用製造装置の売上が中心。

PVE
(太陽光パネル製造装置)

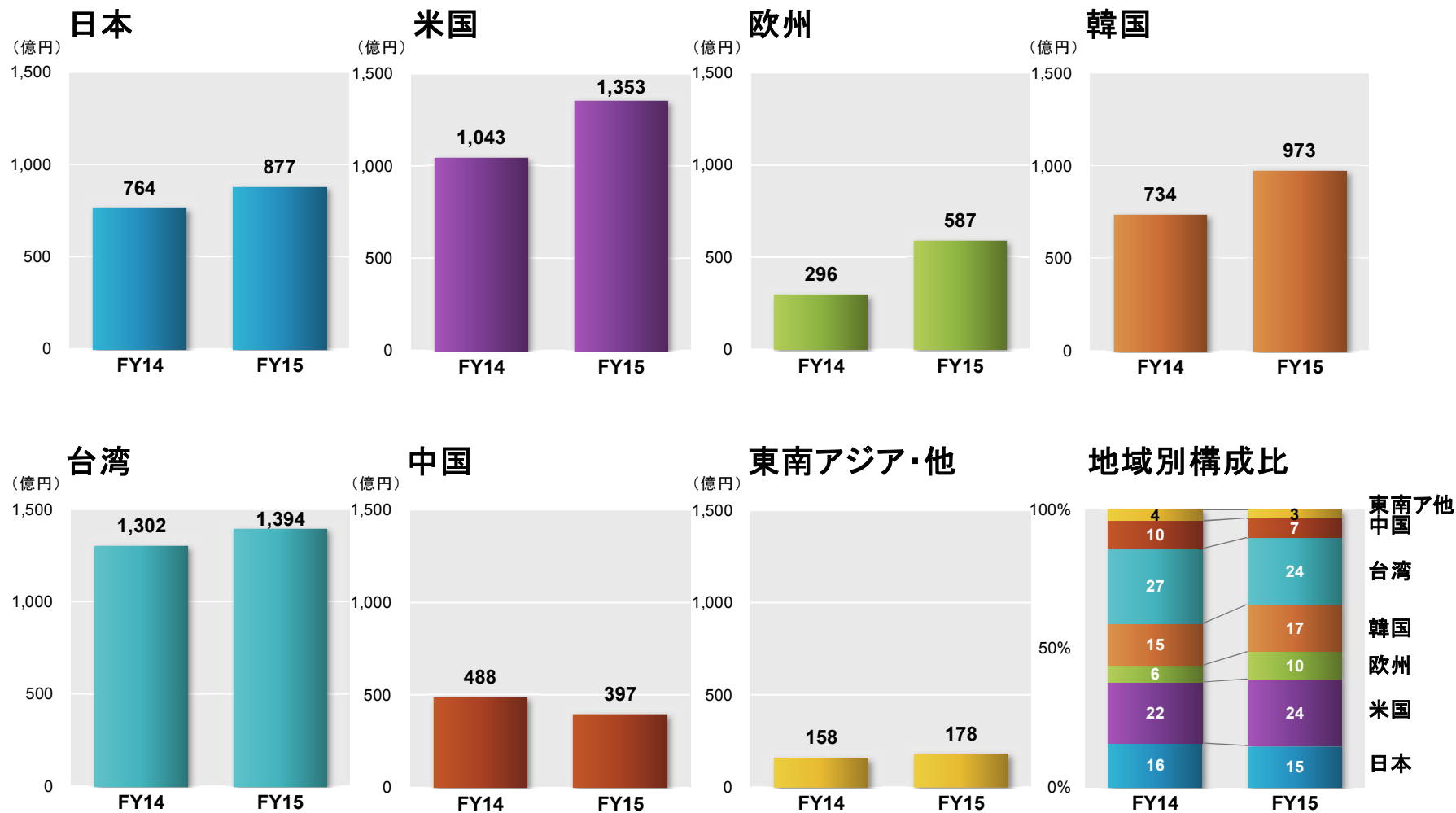
2014年3月末で製造開発および販売活動を終了。納入装置のサポートのみ継続。

セグメント情報



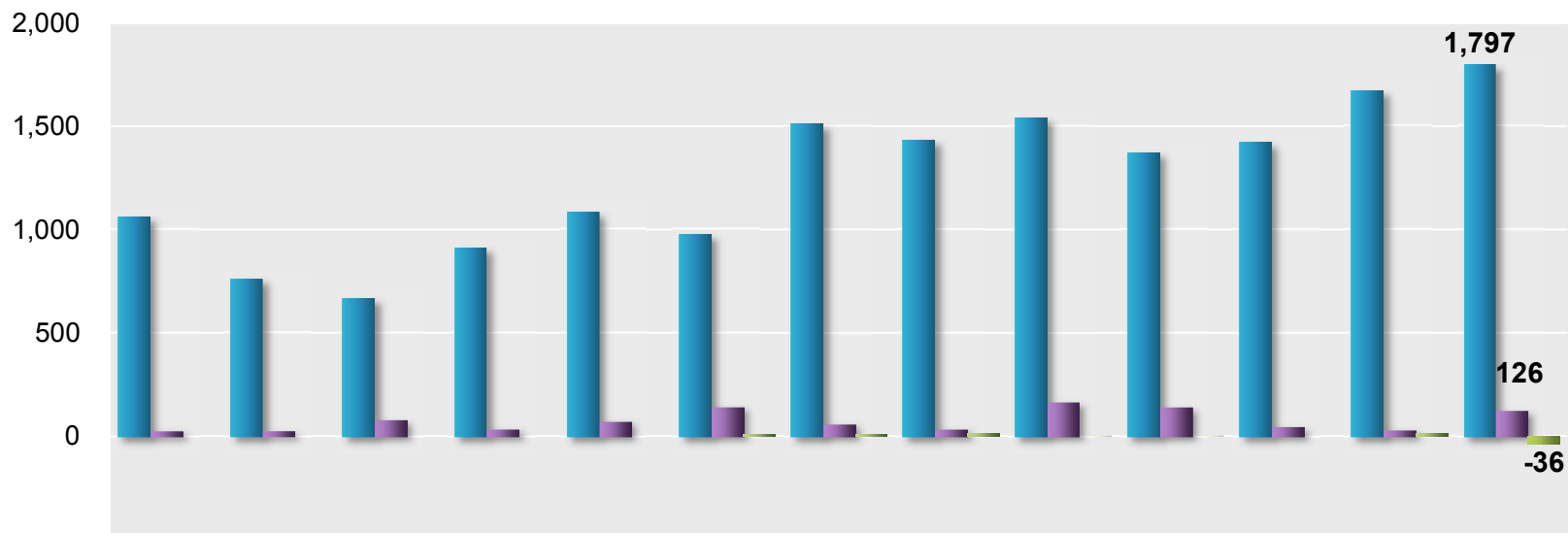
1. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究費および減損損失等を全社費用としています。(FY14; 415億円、FY15; 402億円)
2. セグメント利益は、税前利益です。

SPE部門地域別売上高



受注額・受注残高

(億円)

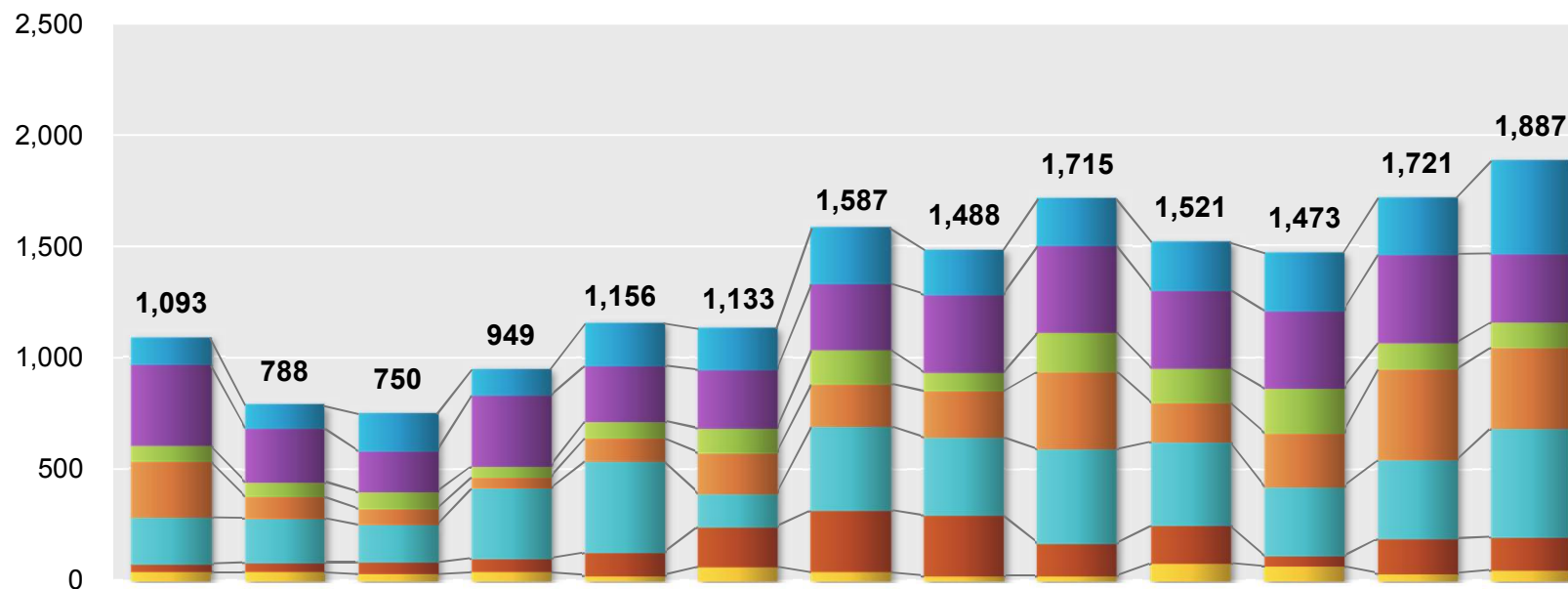


	FY12/4Q	FY13/1Q	FY13/2Q	FY13/3Q	FY13/4Q	FY14/1Q	FY14/2Q	FY14/3Q	FY14/4Q	FY15/1Q	FY15/2Q	FY15/3Q	FY15/4Q
SPE受注額	1,064	760	669	913	1,082	977	1,513	1,434	1,544	1,372	1,424	1,672	1,797
FPD受注額	28	27	80	36	73	144	63	38	166	142	48	34	126
PVE受注額	-	0	0	0	0	11	11	14	5	5	0	14	-36
SPE受注残高	1,886	1,577	1,187	1,426	1,416	1,645	1,960	2,372	2,099	2,110	2,170	2,523	2,604
FPD受注残高	142	122	158	148	160	255	274	225	290	293	291	288	316
PVE受注残高	-	0	-	84	84	76	74	77	89	84	72	75	36

FY12/4Q以前のPVEの受注額および受注残高はFPDとの合計額で表示しています。

地域別受注額：SPE+FPD+PVE

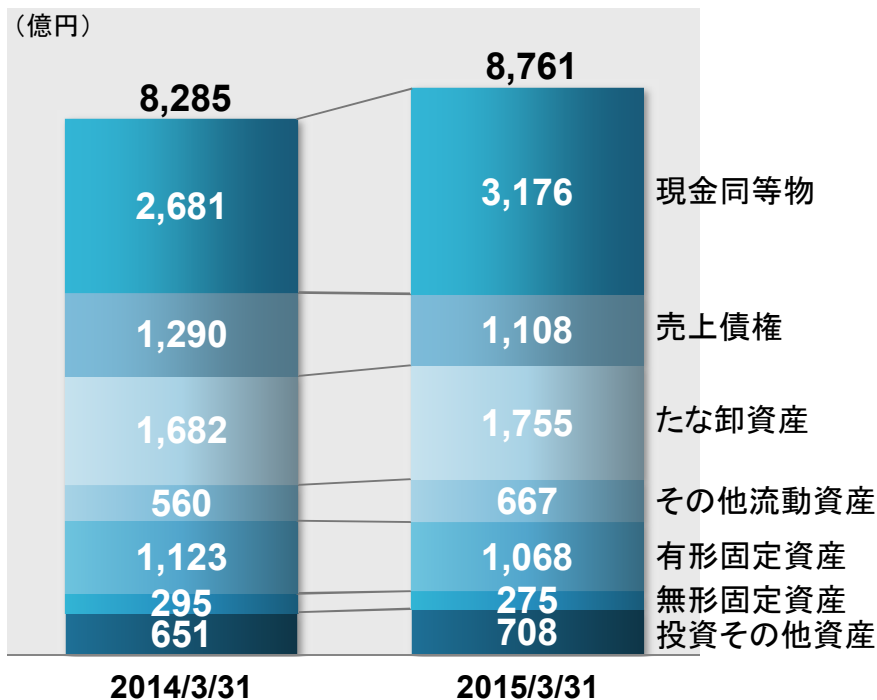
(億円)



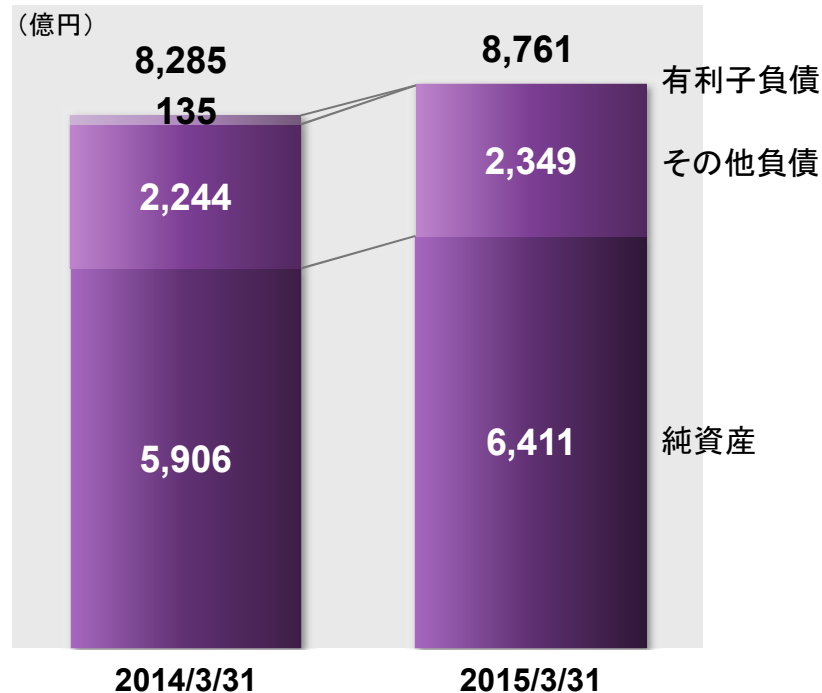
	FY12 4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q	2Q	3Q	4Q	FY15 1Q	2Q	3Q	4Q
■ 国内	117	100	163	115	187	183	247	196	209	212	259	252	414
■ 米国	368	240	184	317	249	264	298	353	389	352	348	396	308
■ 欧州	70	68	77	50	77	109	153	85	175	155	199	120	114
■ 韓国	251	97	73	52	105	182	191	206	350	176	241	410	361
■ 台湾	210	200	167	313	410	149	378	352	423	377	313	351	492
■ 中国	37	44	54	64	102	183	280	270	144	169	45	157	149
■ 東南アジア・他	37	36	28	36	24	61	36	22	23	77	65	32	46

貸借対照表

資産



負債・純資産

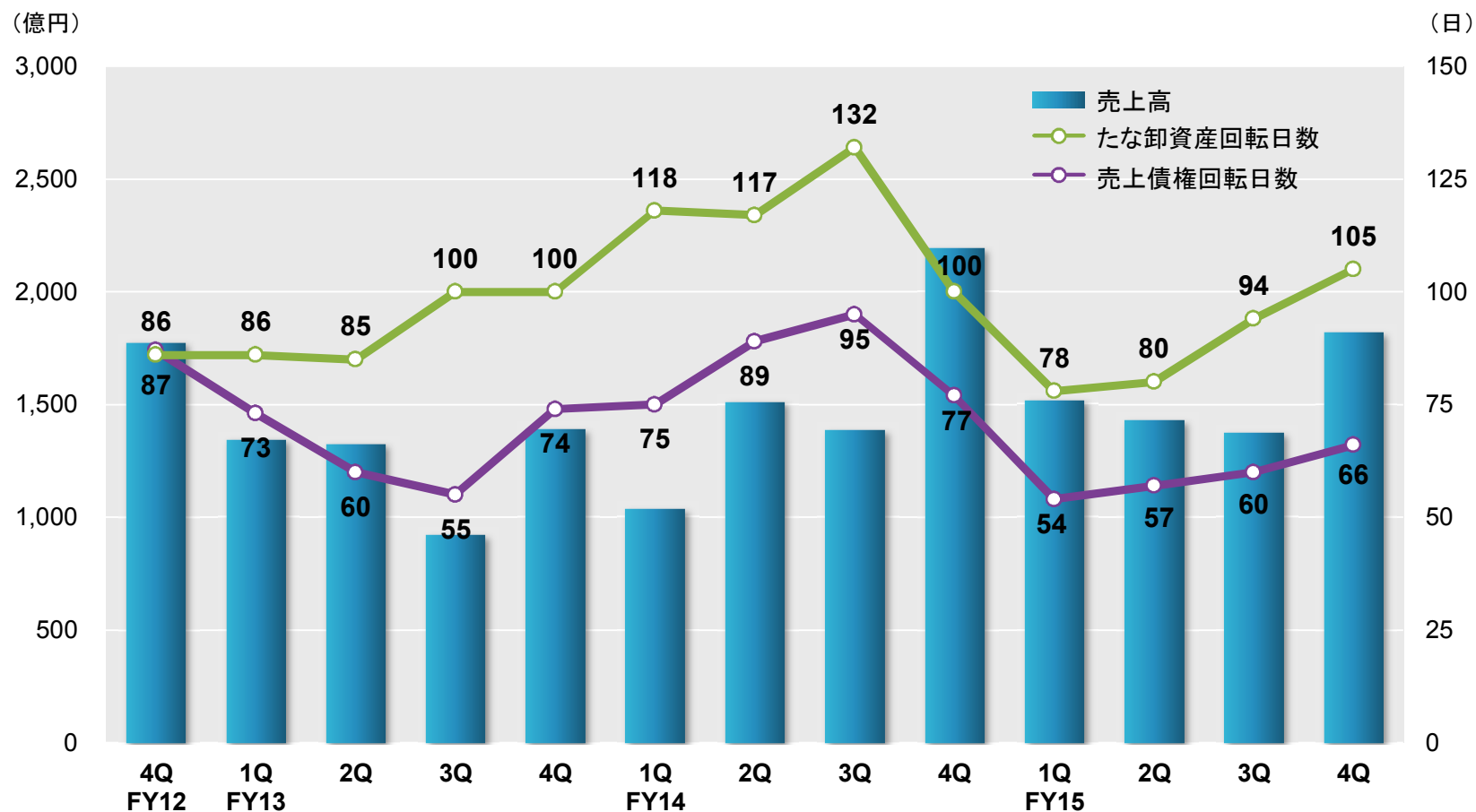


2014/3/31
ご参考:期首との比較

		期首からの増減(億円)
資産	現金同等物	+508
	売上債権	+45
	たな卸資産	+287
	有形固定資産	-44
負債	買掛金	+106

現金同等物: 現預金+短期投資等(貸借対照表上の表示は「有価証券」)

たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)

	2014年3月期	2015年3月期
営業キャッシュ・フロー	444	718
税前利益	△117	868
減価償却費	248	208
減損損失	469	25
売上債権の減少(△増加)	△253	△13
たな卸資産の減少(△増加)	△320	△268
仕入債務の増加(△減少)	156	94
法人税等の支払額または還付額	△17	△242
その他	279	45
投資キャッシュ・フロー	△195	1,557
設備投資	△94	△118
満期3ヵ月超の預金等の増減額	△85	1,633
その他	△16	43
財務キャッシュ・フロー	△1	△182
配当金支払い	△91	△179
その他	89	△2
現金及び現金同等物の期末残高	1,047	3,176
満期3ヵ月超の定期預金・短期投資の期末残高	1,633	0
現金及び現金同等物＋満期3ヵ月超の定期預金・短期投資等の期末残高	2,681	3,176

補足資料



TOKYO ELECTRON

Corp IR/April 27, 2015

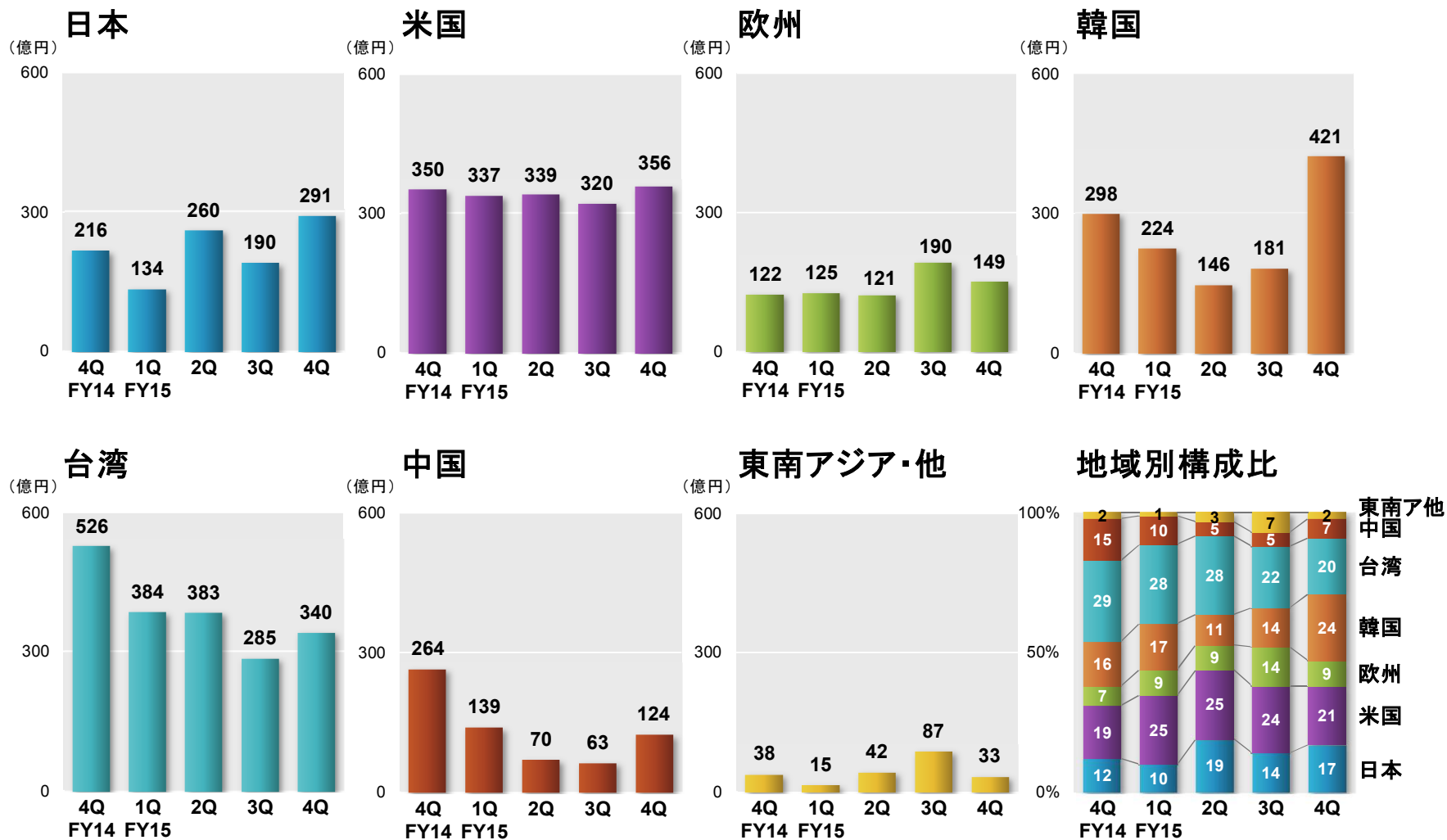
業績サマリー

(億円)

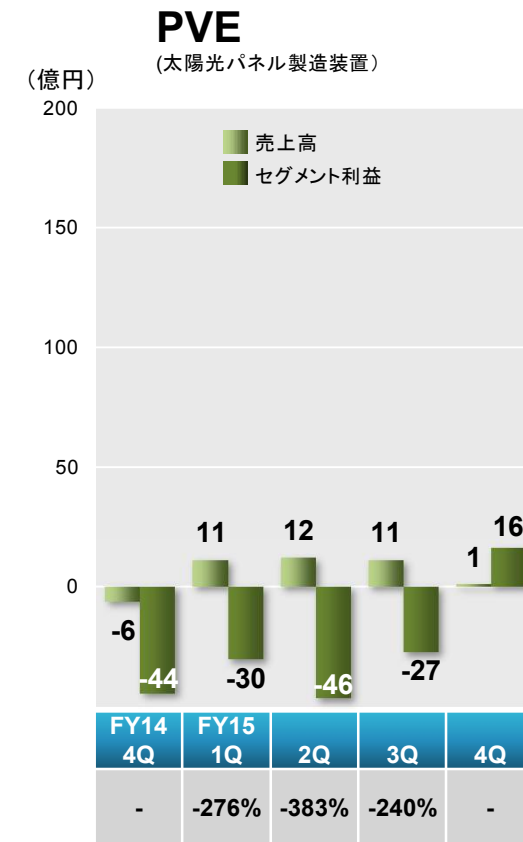
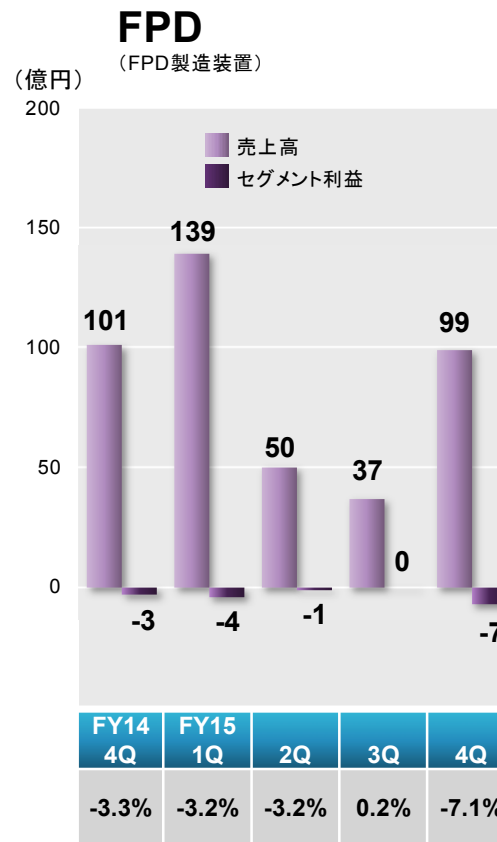
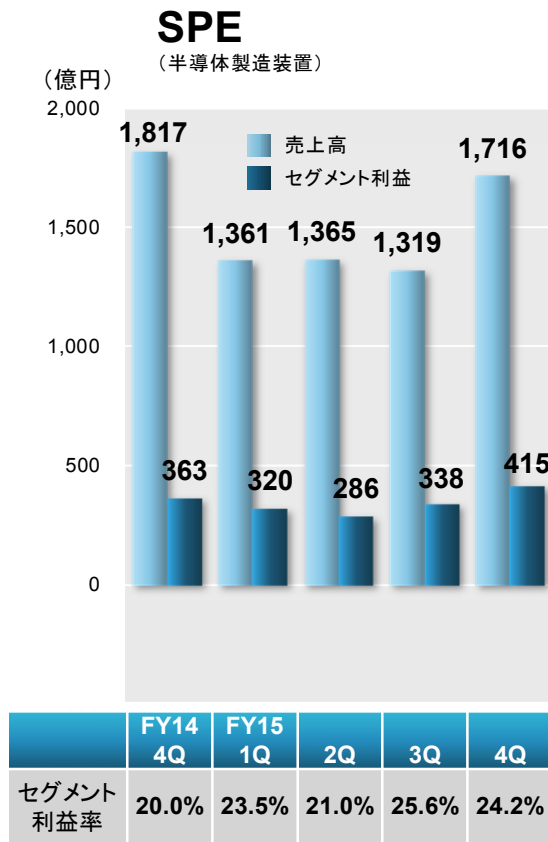
	2014年3月期	2015年3月期					対前年4Q 増減率
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	2,192	1,513	1,429	1,370	1,818	-17%	
SPE	1,817	1,361	1,365	1,319	1,716	-6%	
FPD	101	139	50	37	99	-2%	
PVE	-6	11	12	11	1	-	
EC/CN	279						
その他	1	1	1	1	1	-8%	
売上総利益	715	553	520	576	776	+9%	
下段: 売上総利益率	32.6%	36.6%	36.4%	42.1%	42.7%		
販管費	465	383	390	355	417	-10%	
営業利益	249	170	130	220	359	+44%	
下段: 営業利益率	11.4%	11.3%	9.1%	16.1%	19.8%		
税前利益	257	150	140	247	329	+28%	
当期純利益	162	118	81	174	344	+112%	
研究開発費	212	167	181	168	195	-8%	
設備投資額	45	37	35	26	32	-29%	
減価償却実施額	62	47	50	54	56	-9%	

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

SPE部門地域別売上高



セグメント情報

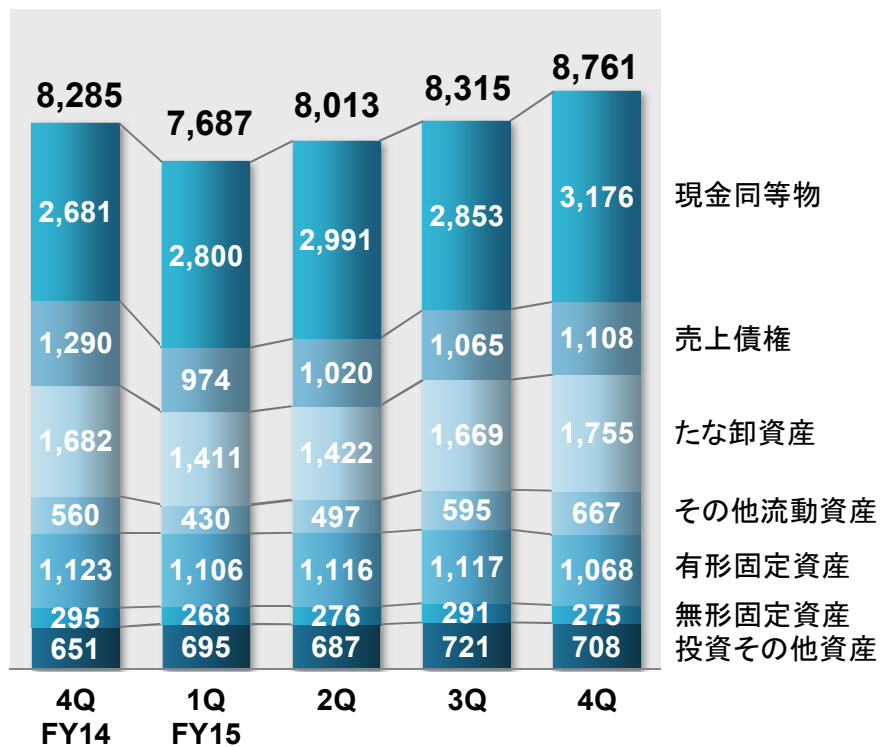


1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用(主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費)があります。

貸借対照表

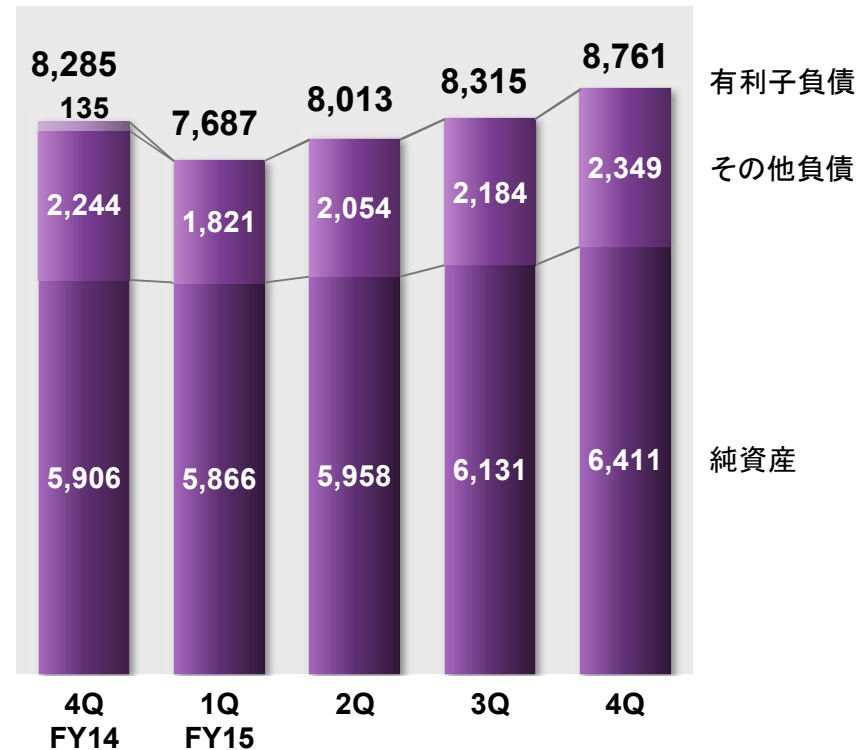
資産

(億円)



負債・純資産

(億円)



現金同等物: 現預金 + 短期投資等 (貸借対照表上の表示は「有価証券」)

従業員数

(人)

		2014年3月末	2015年3月末
	国内	8,205	7,166
	米国	1,652	1,622
	欧州	888	644
	アジア	1,559	1,412
合計		12,304	10,844



事業環境と収益性向上への取り組みについて

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2015年4月27日

2015年3月期 事業ハイライト



TOKYO ELECTRON

Corp IR/April 27, 2015

2015年3月期 事業ハイライト

▶ SPE事業の収益性および製品競争力が向上

- 前期比20%増の売上を達成、市場成長をアウトパフォーム
- 半導体前工程市場におけるシェアが10.5%から13.6%に向上
- 注力分野の洗浄およびエッチング装置事業のシェアが拡大
- フィールドソリューション事業の売上は前期比35%程度の増加
- 継続的な開発、製造の効率化により収益性が向上

主力SPE事業の収益性、競争力が向上

2015年3月期 事業ハイライト

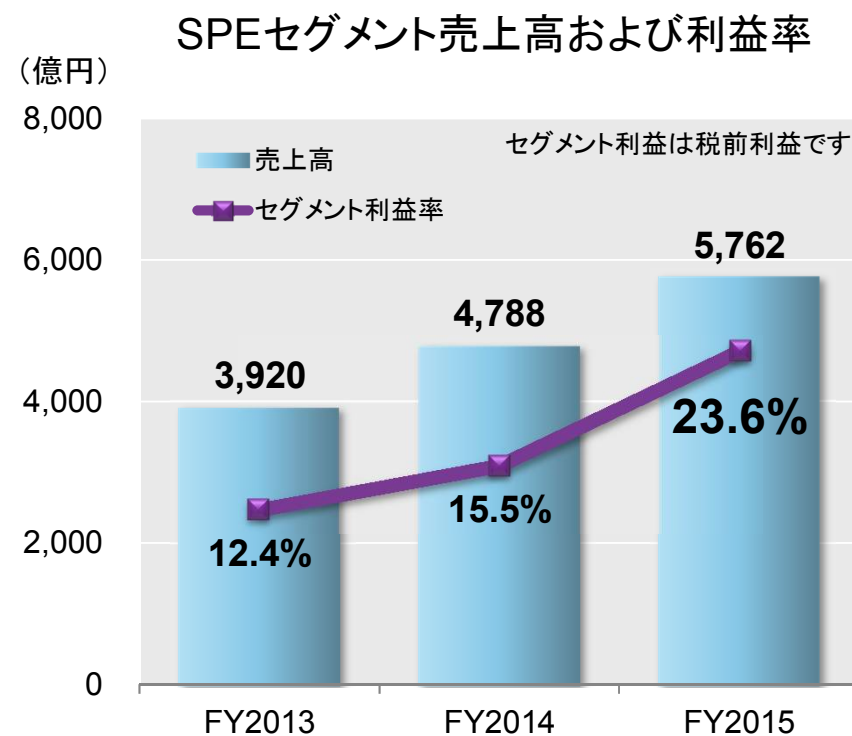
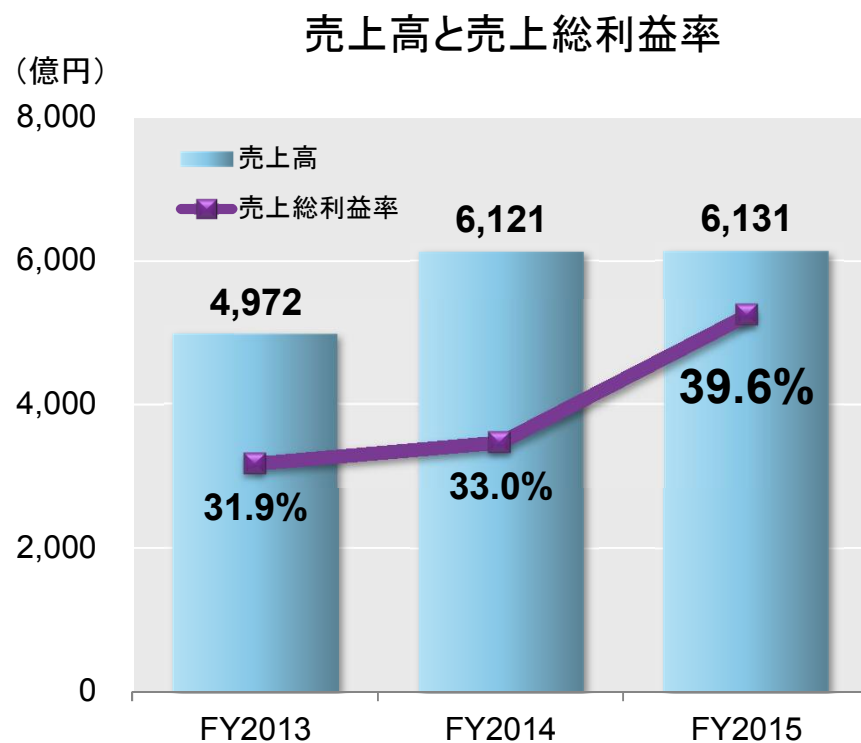
▶ SPE/FPD事業へ経営資源集中

- 太陽光パネル製造装置事業からの撤退が予定通り進捗
 - TEL Solar AGの解散予定および同社に対する債権放棄を決議、本年6月より清算手続きを開始し、2016年7月に清算完了予定
 - 今期は保守サービスのみ継続、大幅な損失縮小を見込む

- 電子部品/コンピュータ・ネットワーク事業の非連結化を実施
 - 東京エレクトロン デバイス株式会社の株式を一部売却、同社は連結子会社から持分法適用関連会社に変更

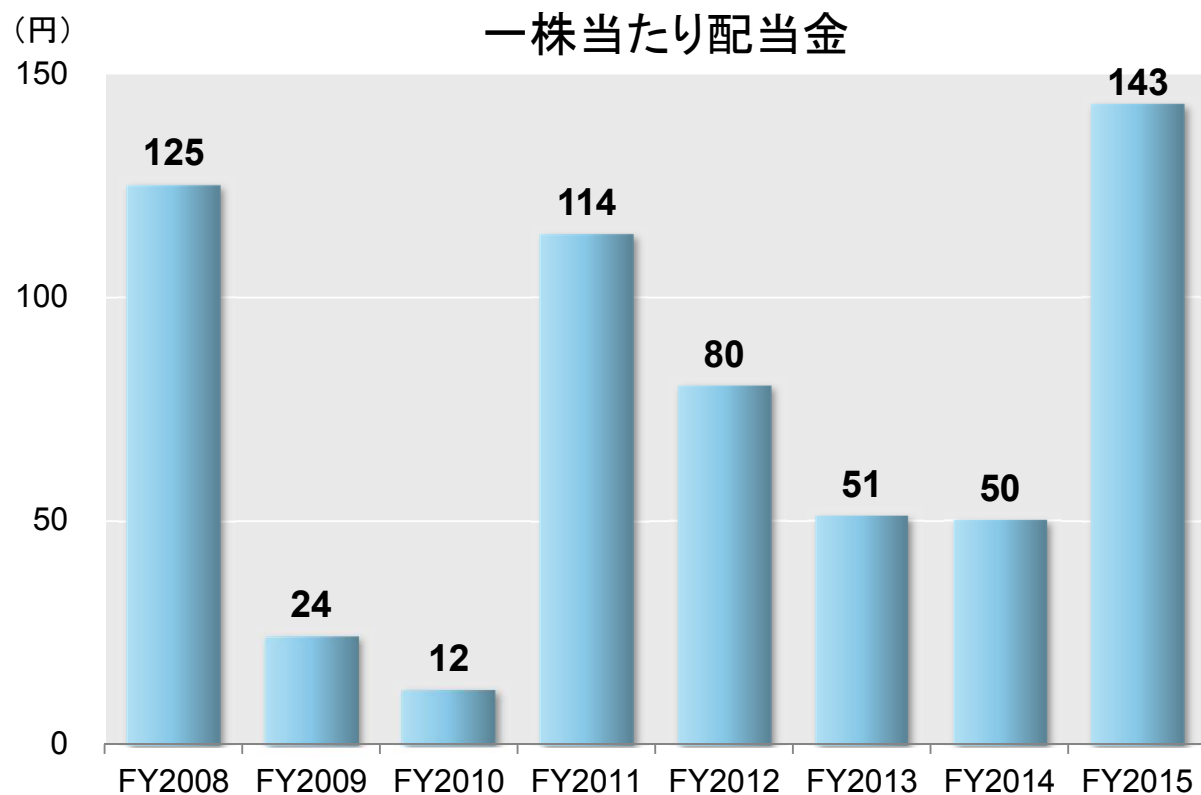
一層の収益性向上を目指した事業再編を実施

2015年3月期 事業ハイライト



過去最高の売上総利益率および
過去最高と同率のSPEセグメント利益率を達成

2015年3月期 事業ハイライト



FY2013の配当51円には、創立50周年記念配当20円(中間期10円、期末10円)を含みます。
FY2011の期末配当より、業績連動配当性向を従来の20%目途から35%目途に引き上げています。

FY2015は過去最高の配当金

市場環境と事業戦略



TOKYO ELECTRON

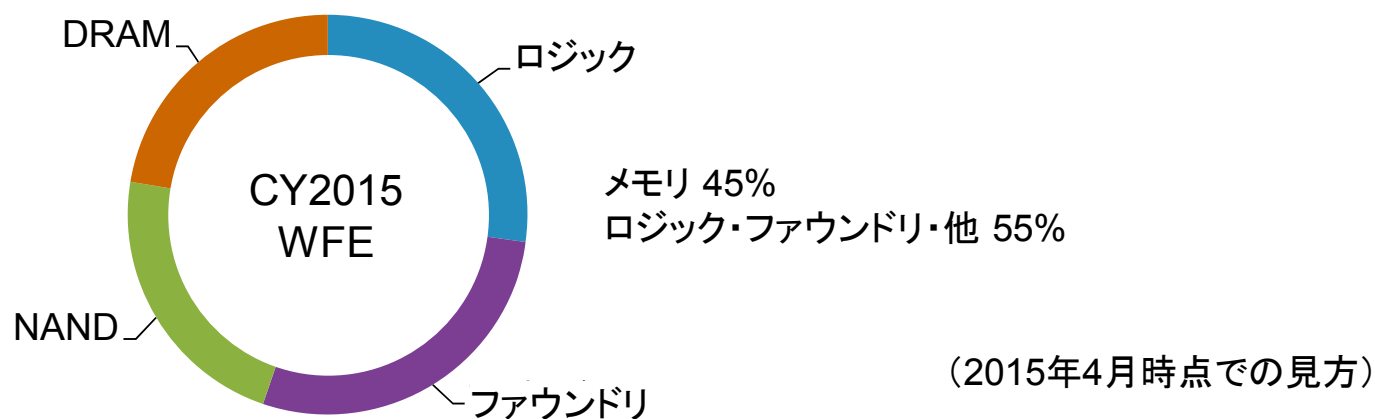
Corp IR/April 27, 2015

市場環境

▶ 半導体設備投資

CY2015の半導体前工程(WFE)の設備投資額は、前年比5%前後の増加を見込む。好調なモバイル需要とデータセンタ向けサーバの高性能・低消費電力化を背景に、半導体需要は堅調であり、メモリ向けを中心に設備投資が拡大すると予想。

- DRAM/NAND: 活発な増産投資が継続
- ファウンドリ: 1X世代先端ロジック向け投資開始
- ロジック: サーバ向けの堅調な需要により、安定的な投資継続



2015年 半導体設備投資の牽引役

- ▶ 好調なモバイル需要とサーバの高性能・低消費電力化が2015年の半導体設備投資を牽引



ロジック・メモリ共に旺盛な投資が継続

モバイルDRAM
ビット成長率 50-55%
搭載容量 1GB⇒2GB/3GB

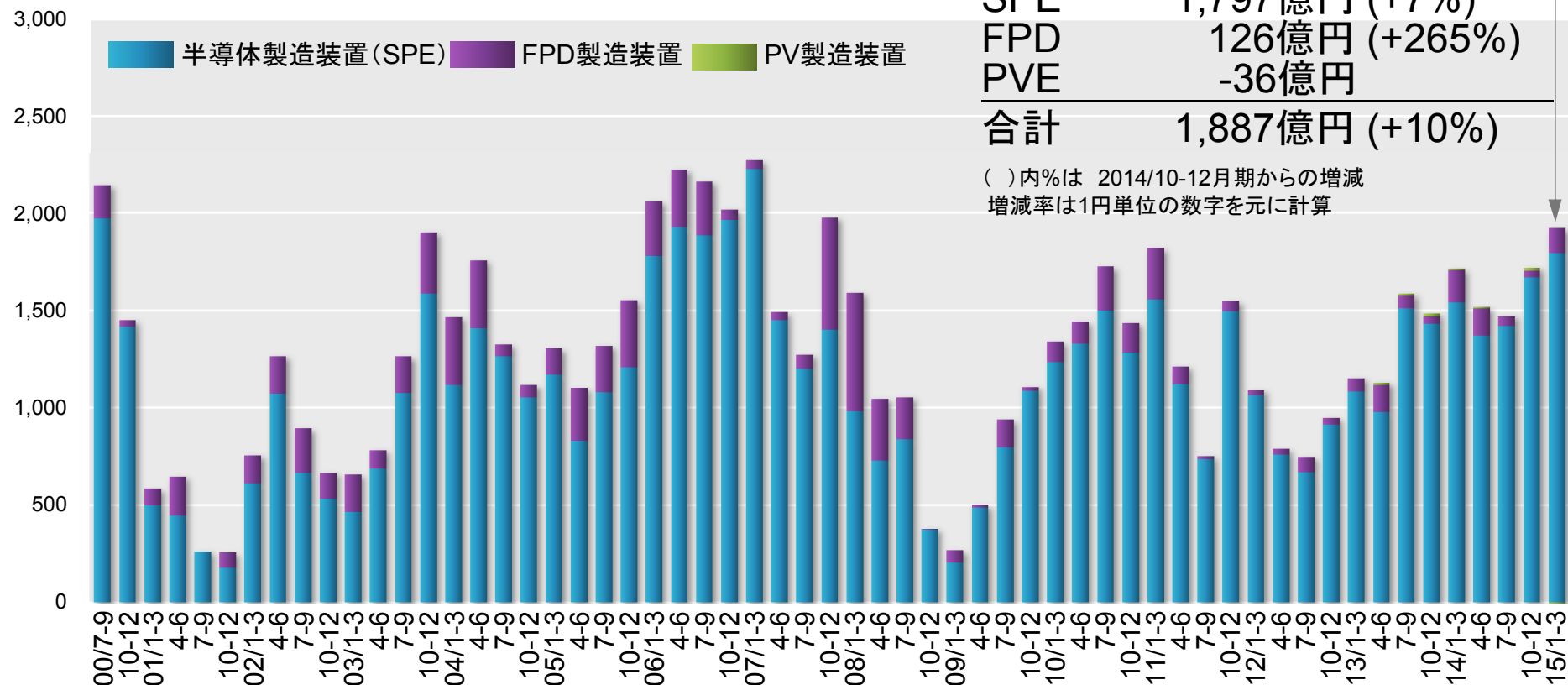
サーバDRAM
搭載容量 30-35%

先端ロジック
高性能/低消費電力化
1Xnm FinFET

サーバ/PC向けSSD
ビット成長率 55-60%

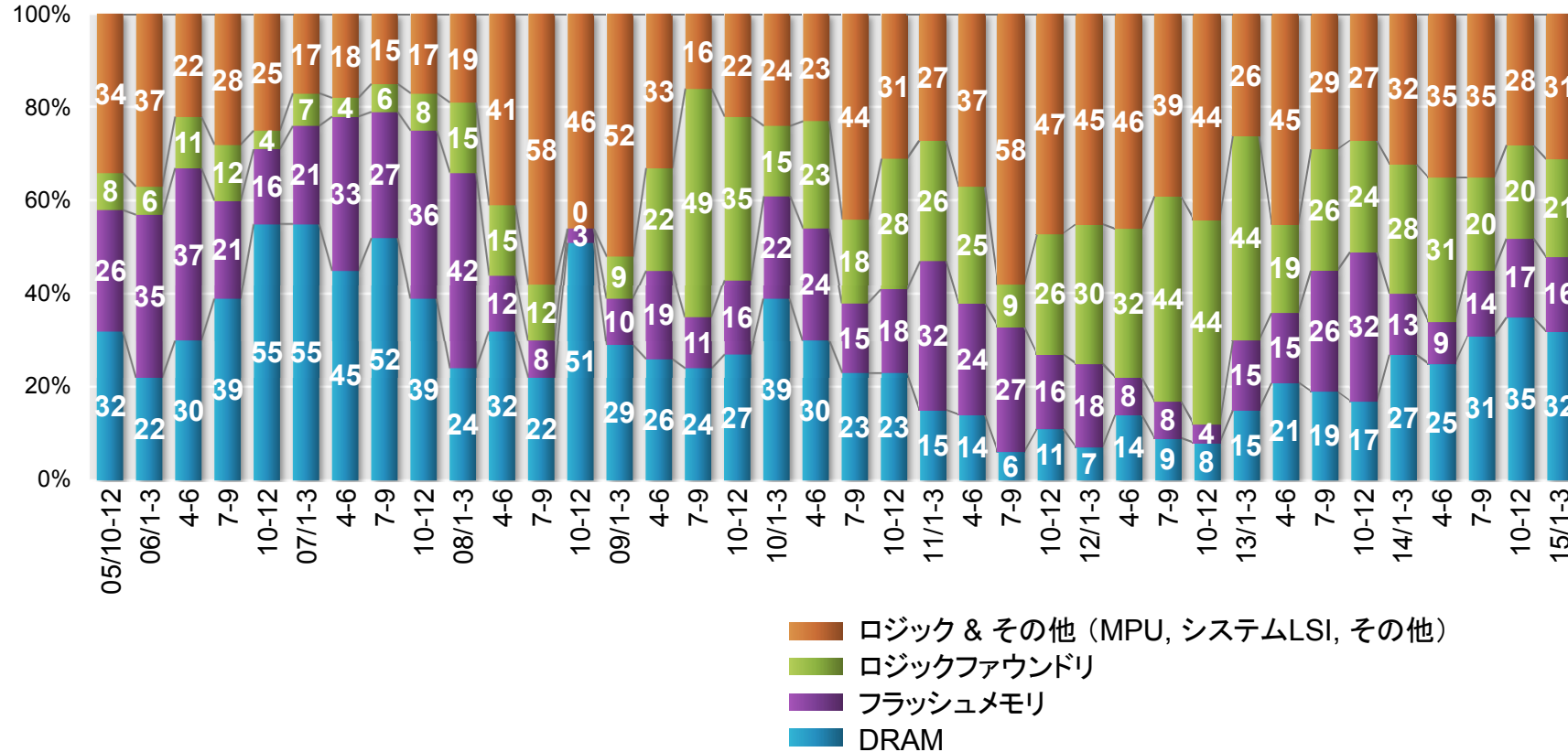
四半期 受注額

(億円)



2012/1-3月期以前のPV製造装置の受注額は
FPD製造装置の値に含まれています。

アプリケーション別SPE受注額



グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

SPE事業戦略

洗浄装置

▶ 前期の結果

- 2013年比シェア大幅向上：
メモリ、ロジック向け共に微細化に対応した独自技術による製品展開が予定通り進捗、過去最高のシェアを実現

▶ 今期の重点課題

- 独自技術による製品戦略を加速、枚葉洗浄装置の採用工程拡大
- ドライ洗浄装置の採用アプリケーションの拡大



枚葉洗浄装置
CELLESTA™-i

エッチング装置

▶ 前期の結果

- 2013年比シェア向上：
- メモリ向けのパターンニング、HARC工程において収益拡大
- STT-MRAM向けの装置でPOR取得

▶ 今期の重点課題

- 継続して市場拡大が見込まれるパターンニング工程に注力
- メモリ向けのHARC工程において採用工程拡大



プラズマエッチング装置
Tactras™

STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory, HARC: High Aspect Ratio Contact

SPE事業戦略

熱処理成膜装置

▶ 前期の結果

- 2013年比シェア向上：
重要度の増すALD市場でメモリ、ロジック向け共に採用工程拡大

▶ 今期の重点課題

- 今後も継続して成長が見込まれるALD市場に注力
- 最新モデル(NT333)で採用アプリケーションの拡大



ALD成膜装置
NT333™

コータ/デベロッパ

▶ 前期の結果

- 2013年比シェア高位維持：
ディフェクト低減機能によるOEE改善やランニングコスト削減を実現する最新機種と総合サポート力が継続して顧客の高い評価を得る

▶ 今期の重点課題

- 液浸10nmノード以細向け先端パターンニング技術の開発加速
- 次世代リソグラフィ技術(EUV/DSA)向けの開発継続



コータ/デベロッパ
CLEAN TRACK™
LITHIUS Pro™ Z

OEE: overall equipment efficiency, EUV: extreme ultraviolet, DSA: directed self-assembly

SPE事業戦略

枚葉成膜装置

▶ 前期の結果

- 2013年比シェア向上：
拡大するメタルALD市場において薄膜制御性、低温、均一性に優れたメタル成膜装置 (Triase+ EX-II) の製品展開が計画通り進展
- STT-MRAM向けPVD装置が複数顧客に採用、高い評価を得る

▶ 今期の重点課題

- Triase+ EX-IIのロジック顧客への展開



メタル成膜装置
Triase+™ EX-II™

テストシステム/3DI

▶ 前期の結果

- 2013年比シェア向上：
新規製品投入したテスター一体型マルチセルテストシステムが複数顧客に採用、テストコスト削減に寄与し高い評価を得る
- 台湾にてプローバ装置の製造開始、収益性改善に寄与

▶ 今期の重点課題

- Cellciaの顧客展開、IMEにて先端パッケージング技術の開発加速



テスター一体型
マルチセルテストシステム
Cellcia™

STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory, IME: Institute of Microelectronics

SPE事業戦略

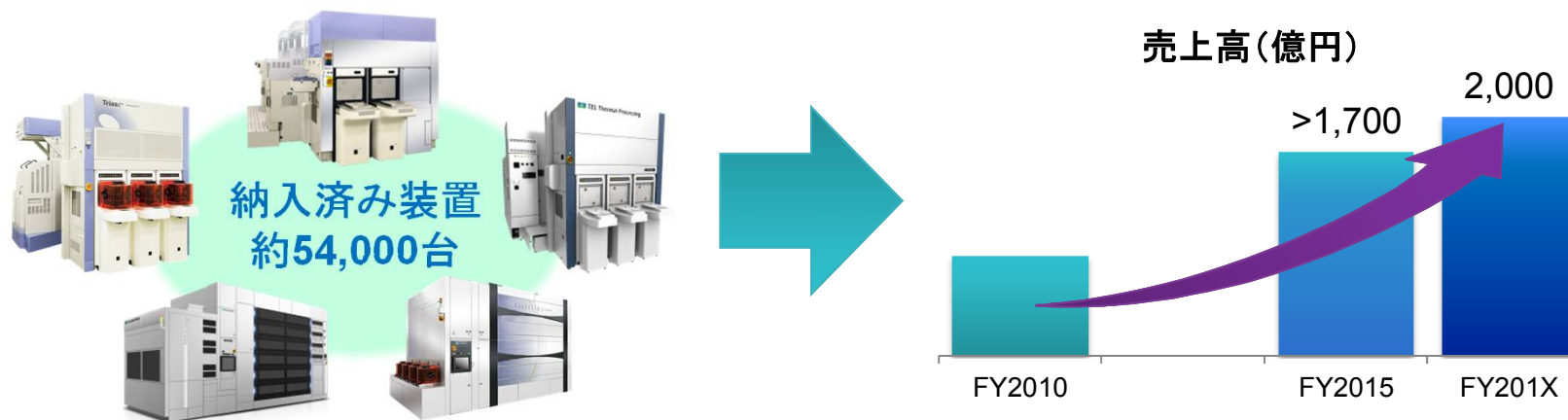
フィールドソリューション(FS)

▶ 前期の結果

- 2009年にFSBUを新設して以来、目標として掲げてきた年間売上高1,500億円を超える1,700億円以上を達成

▶ 今期の重点課題

- 需要の一層の拡大が見込まれる中古改造ビジネスにおいて収益拡大を図る
- 顧客のオペレーションコスト低減を目指した新サービス(eMetrics)の提供によりサービス売上拡大を目指す



高いソリューション能力をもつ装置メーカーへの期待が高まる

SPE事業戦略

STT-MRAM

- ▶ 高生産性と薄膜制御技術が評価され複数顧客で装置採用
- ▶ 顧客・東北大学・各コンソーシアとの共同開発で技術をリード

MTJ形成に必要な製品をすべて保有



STT-MRAMの特長

- ◆ 不揮発性メモリ
- ◆ 高速・低消費電力
- ◆ 高集積化が可能

次世代メモリの実用化に向けて量産技術の確立を目指す

STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory

MTJ: Magnetic Tunnel Junction

FPD市場環境と事業戦略

▶ FPD設備投資

- CY2015の液晶パネル用製造装置の需要は、大型パネル向け設備投資の増加に加えて、モバイル用途の中小型パネル向けの投資も開始され、前年比20%の増加を見込む。有機ELテレビ市場の立ち上がりは2017年以降。

(2015年4月時点での見方)

▶ 事業戦略

- 高精細パネル(4K)、OLED等の新しい技術ニーズに対応した最新モデルのICPエッチング装置により、継続して収益拡大を図る。
- インクジェット方式の有機EL成膜装置の拡販を目指す。



有機ELパネル製造用インクジェット描画装置
Elius™ 2500

- 材料使用効率に優れる
- 大気圧下でのプロセスが可能

2016年3月期 業績予想



TOKYO ELECTRON

Corp IR/April 27, 2015

2016年3月期 業績予想

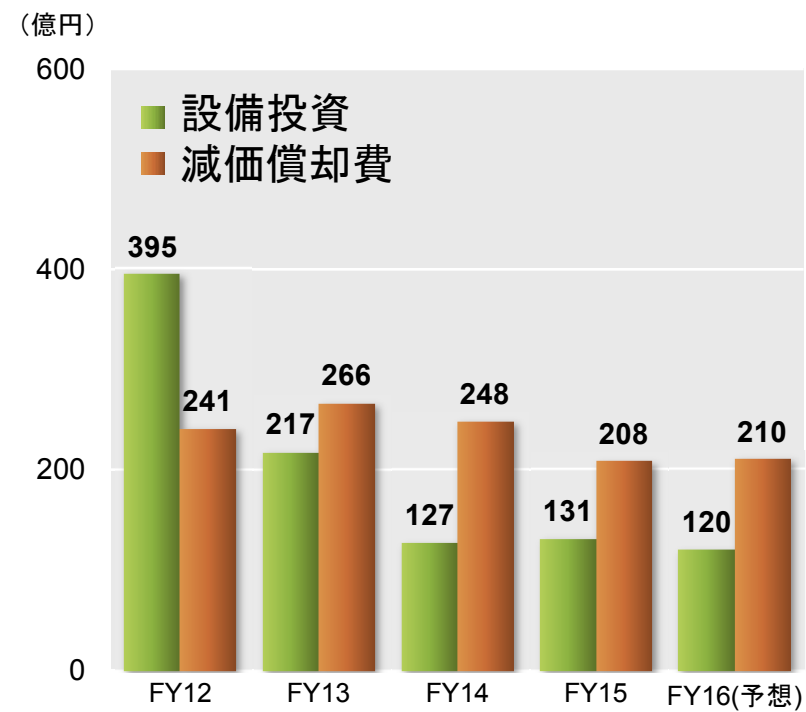
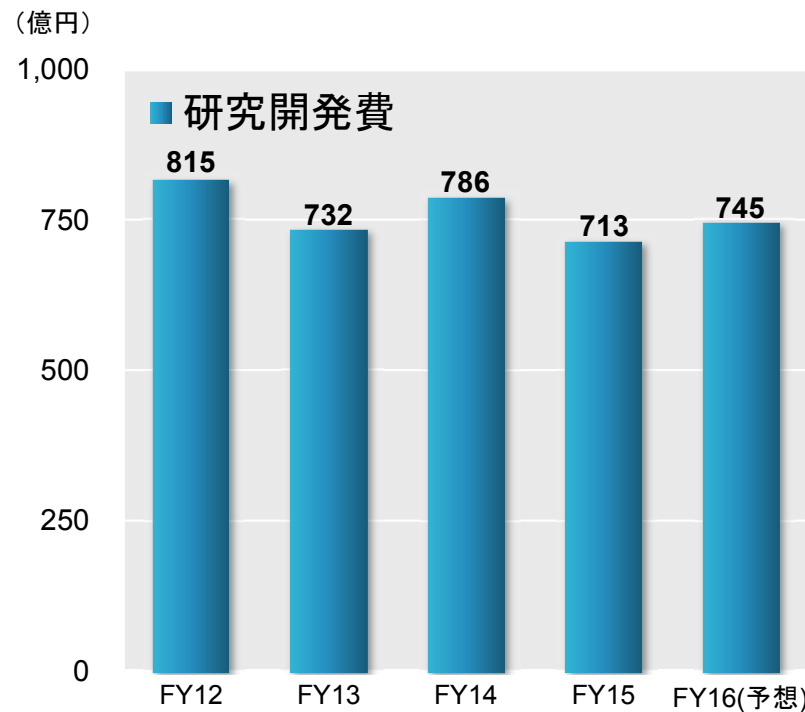
▶ 市場成長を上回る売上拡大により27%の営業増益を見込む

(億円)

	FY2015 (実績)	FY2016(予想)			
		上期	下期	通期	対前年増減
売上高	6,131	3,200	3,550	6,750	+10%
SPE	5,762	3,000	3,250	6,250	+9%
FPD	327	175	295	470	+44%
PVE	36	25	5	30	-
営業利益	881	470	650	1,120	+27%
下段: 営業利益率	14.4%	14.7%	18.3%	16.6%	+2.2pts
税前利益	868	460	650	1,110	+28%
当期純利益	718	330	460	790	+10%

SPE: 半導体製造装置 FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置 PVE: 太陽光パネル製造装置

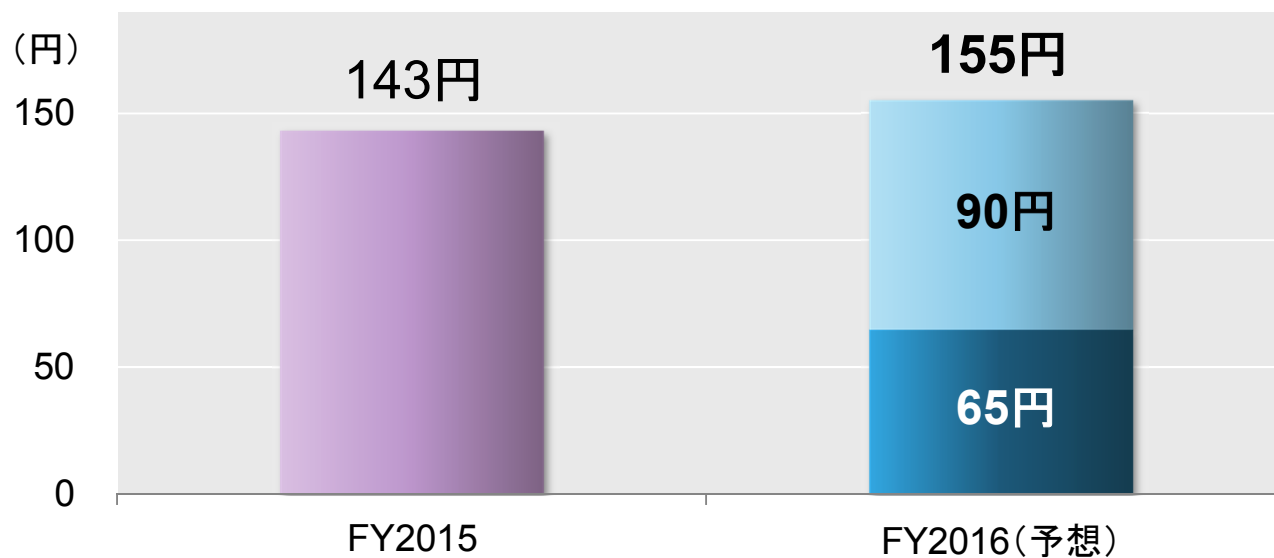
研究開発費・設備投資計画



成長のための開発投資は高位維持、設備投資は抑制

2016年3月期 配当予想

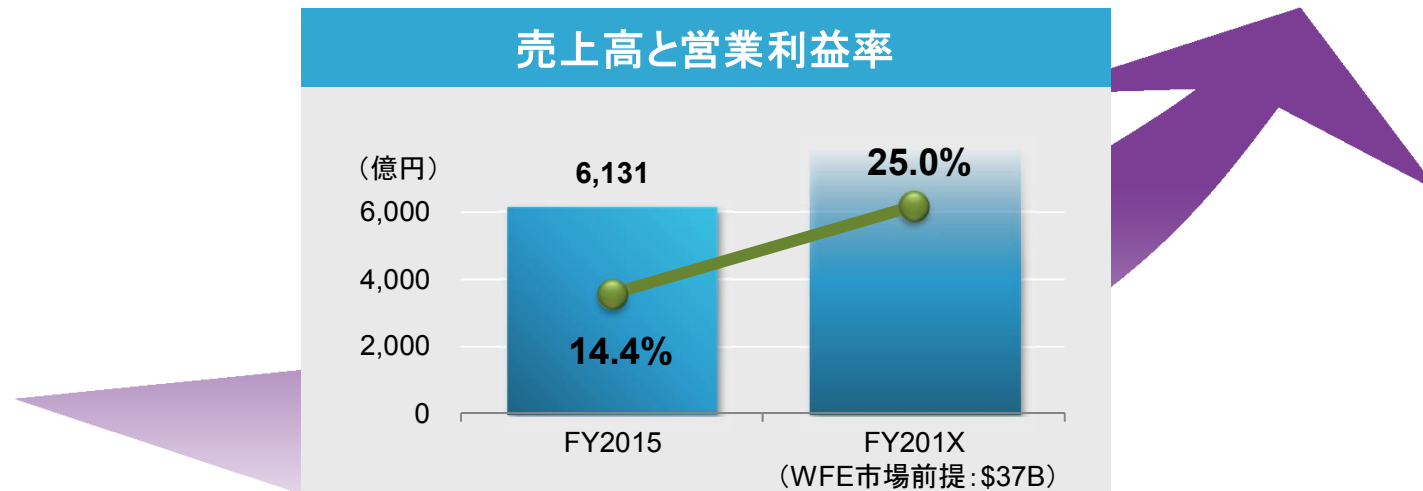
1株当たり配当金(予想)		
中間配当	期末配当	合計
65円	90円	155円



FY2016も過去最高の配当金を予定

技術の変革点で収益性向上

- ▶ デバイスの3次元化や新材料の採用が成長機会を創出、革新的な製品投入で収益性およびシェア向上を目指す
- ▶ 開発・製造の効率性を高め、一層の利益率向上に取り組む
 - 設計段階からのコストダウンを継続
 - 開発・製造・サービス一体による品質改善、生産リードタイムの短縮



中期的に営業利益率25%以上を目指す

自社株式の買い入れについて

最大1200億円の自社株式取得を予定

- 取得対象株式の種類 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数: 1,540万株(上限)
- 株式の取得価額の総額: 1,200 億円(上限)
- 取得する期間: 2015年5月14日～2016年5月13日

保有する現金は、さらなる企業価値向上のための事業拡大、革新的ソリューションの開発に活用していきますが、今後のキャッシュ・フロー等も考慮して決定いたしました。

今後も一層の株主価値向上に取り組んでまいります

新たなるチャレンジ

- ▶ 新たな取り組み課題も加えた、新中期経営計画を策定
- ▶ 資本政策を見直し、より魅力ある株主還元策を検討

東京エレクトロンの
変革へのチャレンジは続きます

▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、為替レート変動による収益への影響は極めて軽微です。

FPD/PV：フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

